

BEST AVAILABLE COPY

(54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 1-22051 (A) (43) 25.1.1989 (19) JP

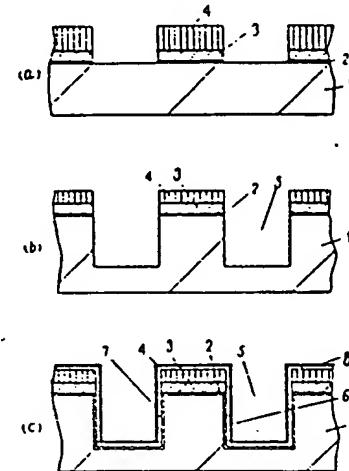
(21) Appl. No. 62-179482 (22) 17.7.1987

(71) MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD (72) NORIHIKO TAMAOKI(1)

(51) Int. Cl. H01L21/94, H01L21/76

PURPOSE: To prevent the acid resistant mask from being etched in the later isotropical etching process by a method wherein, after a silicon nitride film as a second acid resistant film is formed on the whole semiconductor substrate surface, the surface of this silicon nitride film is oxidized to form a silicon oxide film as an anti-etching mask which is thin and has no pin holes.

CONSTITUTION: On an N-type substrate 1, a thermal oxide film 2, a silicon nitride film 3 and a silicon oxide film 4 are sequentially formed, and with the silicon oxide film 4 as a mask they are etched to form opening parts 5. With the silicon nitride film 3 as a mask, a thermal oxidation is performed to form a thermal oxide film 6 on the side and bottom of the opening parts. Thereafter, a silicon nitride film 7 is formed on the whole surface by a low pressure CVD method or the like, and subsequently a heat treatment is performed in an oxidation atmosphere to oxidize the surface of the silicon nitride film 7, thereby forming a silicon oxide film 8. With this, even if there are pin holes in the silicon oxide film which is later deposited on the silicon nitride film 7, the etching of the silicon nitride film 7 is prevented since the silicon oxide film 8 acts as an anti-etching mask in the isotropical etching process.



⑨ 日本国特許庁 (JP) ⑩ 特許出願公開
 ⑪ 公開特許公報 (A) 昭64-22051

⑤Int.Cl.
H 01 L 21/94
21/76

識別記号 場内整理番号
D-7131-5F 6708-5F

⑥公開 昭和64年(1989)1月25日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

⑦発明の名称 半導体装置の製造方法

⑧特願 昭62-179482
⑨出願 昭62(1987)7月17日

⑩発明者 玉置 徳彦 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内
 ⑪発明者 久保田 正文 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内
 ⑫出願人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地
 ⑬代理人 弁理士 中尾 敏男 外1名

明細書

1、発明の名称

半導体装置の製造方法

2、特許請求の範囲

(1) 半導体基板に形成された第1の耐エッチング性マスク材と耐酸化性被膜をマスクとして前記半導体基板に開口部を形成する工程と、第2の耐酸化性被膜を抵抗CVD法で半導体基板全面に形成する工程と、第2の耐酸化性被膜を表面を酸化し第2の耐エッチング性被膜を形成する工程と、前記第2の耐エッチング性被膜・耐酸化性被膜を共方位エッティングし前記開口部側面にのみ残存させる工程と、前記第1及び第2の耐エッチング性マスク材をマスクとして等方位ドライエッティングを行なう工程と、前記第1及び第2の耐酸化性被膜をマスクとして半導体基板の酸化を行なう工程を含む半導体装置の製造方法。

(2) 第1及び第2の耐酸化性被膜としてシリコン酸化膜を用いる特許請求の範囲第1項記載の半導体装置の製造方法。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は高密度、高速、低消費電力性を備えた半導体装置の製造方法に関するものである。

従来の技術

半導体集積回路においては高密度・高速化・低消費電力化が追求されつつあり、素子間の分離領域の低減による高密度化やMOS素子におけるソース・ドレインと基板間に発生する寄生容量などの低減による高速・低消費電力化などを狙ってSOI(Silicon On Insulator)構造の開発においてさまざまな試みが実施されている。

第2図は特願昭61-136631号に示された溝掘り分離発底型のSOI構造半導体装置の製造工程の一例を示す断面図である。

第2図は特開昭64-88871号公報に示されている溝掘り分離発底型のSOI構造半導体装置の製造工程の一例を示す断面図である。

まず第2図(a)のように、シリコン基板1の上に選択的に開口されたSi₃N₄膜2を形成する。次

特開昭64-22051(2)

に(b)に示すように、 Si_3N_4 膜2をマスクとして、異方性の強いドライエッチ法、たとえば反応性イオンエッチ(*R.I.E.*)でシリコン基板1に開口部3を形成する。この急峻な開口面に対し第2図(d)のように、 Si_3N_4 膜4を吸圧CVD法によって付着させる。次に(d)に示すように、スパッタエッティング法により Si_3N_4 膜4を除去する。スパッタエッティング法は、エッティングの直線性が並んでいため、側面の Si_3N_4 膜4はエッティングされず、第2図(d)のように Si_3N_4 膜2の上面部及びシリコン基板開口部3底面のみがエッティングされる。その後、第2図(e)のようにシリコン基板1のエッティングを行ない、第2図(f)に示すように酸化を実施し、酸化物領域5を形成すると単結晶シリコン島領域6の下面全域が両側からの酸化によりつながる。その後、単結晶シリコン島領域6表面の Si_3N_4 膜を除去すると、第2図(g)に示すように単結晶シリコン島領域6の下面および側面全てが酸化物領域5により埋まれた構造となる。

発明が解決しようとする問題点

ところが、このシリコン酸化膜膜厚にこのような割損があると、分離領域を決めることが困難になってくる。開口部内の向かいあったシリコン酸化膜が接触してしまうからである。

問題点を解決するための手段

上記問題点を解決するため、本発明では第2の射酸化性液膜としてのシリコン空化膜を半導体基板全面に形成した後、このシリコン空化膜の表面を酸化することにより、薄くかつピンホールのない耐エッティング性マスクとしてのシリコン酸化膜をシリコン空化膜上に形成する。

作用

上記手段により薄くかつピンホールのない耐エッティング性マスクを形成することにより、分離領域を決め、かつ後の等方性エッティング工程で耐酸化性マスクがエッティングされないプロセスを確立することが可能になった。

実施例

第1図は本発明の一実施例における半導体装置の製造工程を示す断面図である。

ここで第2図(e)で示したシリコン基板のエッティングは、次の(第2図(f))酸化工程におけるシリコン島領域の形状安定化や、酸化時間の短縮化によるシリコン島領域内の欠陥の低減化という点から等方的なエッティングにする必要がある。

この等方性エッティングは、高密度化に伴ない場合シリコン島間の分離領域が狭った際のエッティング安定性という観察からドライエッティングで行なうことが望ましい。ドライエッティングではシリコン基板とシリコン空化膜との選択比が低い為、シリコン空化膜上にシリコン空化膜を形成した際と同様のプロセスでシリコン酸化膜を形成するプロセスが必要である。

しかし、シリコン酸化膜形成時には開口部側面に残存させるためのこのシリコン酸化膜をピンホールの存在しない膜厚以上に堆積させないといけない。ピンホールがあるとシリコン酸化膜下のシリコン空化膜が等方性エッティング工程でエッティングされ、酸化工程で所望のシリコン島形状が得られなくなるからである。

第2図と同様第1図において、1はn型(100)シリコン基板で比抵抗は $0.6 \sim 1.0 \Omega \cdot \text{cm}$ である。2は膜厚1000Åのシリコン熱酸化膜、3は耐酸化性被膜としての膜厚2000Åのシリコン空化膜、4は異方性及び等方性の2度のドライエッティング工程における耐ドライエッチマスクとしての膜厚3000Åのシリコン酸化膜である。5は異方性エッティングにより、シリコン基板に形成された開口部、6は膜厚500Åのシリコン熱酸化膜、7は膜厚1000Åのシリコン空化膜、8は膜厚1000Åのシリコン酸化膜、9は等方性ドライエッティングによりシリコン基板に形成された開口部、10はシリコン基板から絶縁分離された素子領域、11は酸化膜領域である。

まず、第1図(a)のようにn型基板1上に熱酸化膜2、シリコン空化膜3、シリコン酸化膜4を順次形成し、素子領域となる部分以外(分離領域)を異方性の強い反応性イオンエッティング(*R.I.E.*)等を用いて開口する。次に第1図(b)に示すように分離領域となる部分をこれも*R.I.E.*等を用いてシ

特開昭64-22051(3)

シリコン酸化膜4をマスクとしてエッティングし、開口部5を形成する。このときシリコン酸化膜4の膜厚は減少するが後の熱酸化膜、シリコン窒化膜の異方性エッティングの下地及びシリコン基板の等方性ドライエッティングのエッティングマスクとして使用できる膜厚(1500Å以上)は残っている。次に第1図(f)のように、シリコン窒化膜3をマスクとして熱酸化を行ない、開口部の側面及び底面に熱酸化膜6を形成し、その後全面にシリコン酸化膜7を成形CVD法等で形成し、統合て酸化窒素気中で熱処理を行ない、シリコン酸化膜7の表面を酸化してシリコン酸化膜8を形成する。

このシリコン窒化膜7の酸化工程が挿入されることにより、後にシリコン窒化膜7上に堆積されるシリコン酸化膜にピンホールがあつても、この酸化工程で形成されたシリコン酸化膜8が等方性エッティング工程で耐エッティング性マスクとして働きシリコン窒化膜7がエッティングされるのを防ぐことになる。

この後、第1図(f)のように、反応性イオンエッ

チング法で異方性の強いエッティングを行なうと、開口部5の側壁部のシリコン酸化膜6、シリコン酸化膜7、シリコン酸化膜8のみを残してその他のシリコン酸化膜、窒化膜が除去される。ここでもシリコン酸化膜4の膜厚は減少するが、後のシリコン基板の等方性ドライエッティング工程でのニッティングマスクとして使用できる膜厚(500Å以上)は残されている。次に等方性ドライエッティング工程でのマスク材としてのシリコン酸化膜を開口部側面のシリコン窒化膜7上に被覆させた形で残すために、前のシリコン酸化膜7で行なったのと同様に成形CVD法等で全面にシリコン酸化膜9を形成し(第1図(g))、反応性イオンエッティング法で側壁部のみを残し、その他のシリコン酸化膜9を除去する(第1図(h))。次にシリコン酸化膜4、8及び9をマスクとしてCF₄・O₂ガスを用いたマイクロ波放電等によるシリコン基板の等方性エッティングを行ない開口部10を形成する(第1図(g))。

繰り返し記述するが、シリコン酸化膜9にピンホールが発生していても、シリコン窒化膜7上にはピンホールのないシリコン酸化膜8が被覆しておりシリコン窒化膜7はエッティングされず、次の選択酸化工程で所望の素子領域形状を再現性良く形成できる。この後第1図(h)に示すように、高圧酸化法により約7気圧の圧力下で酸化を行なうと、酸化される領域はシリコン窒化膜3、7に囲まれていない領域に限定されるため、開口部深さ・酸化時間・素子領域幅を最適化するとシリコン基板1の一部からなる素子領域11が酸化領域12によりシリコン基板と分離・絶縁された構造を得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例における半導体装置の製造方法を示す工程断面図、第2図は従来の溝掘り分離発型SOI構造素子の製造方法を示す工程断面図である。

3、7……シリコン窒化膜、4、8、9……シリコン酸化膜、5……開口部、10……素子領域。

代理人の氏名 井理士 中尾敏男 沢か1名

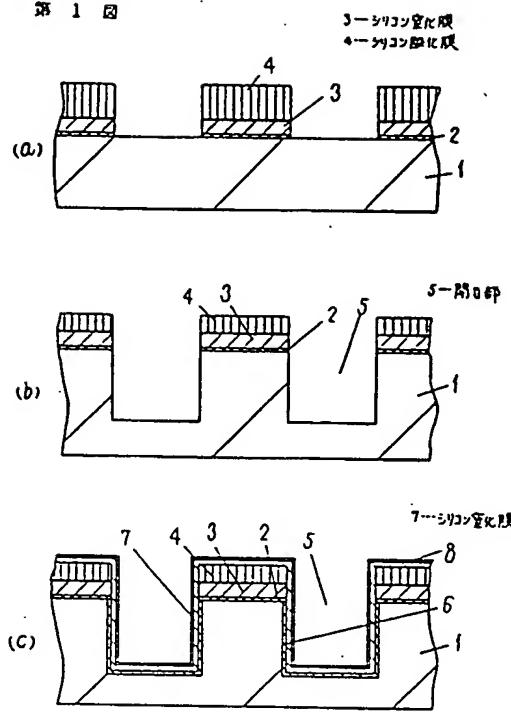
発明の効果

以上説明した発明により、溝掘り分離発展型SOI構造素子の製造技術において、シリコン基板の等方性ニッティングにドライエッチを適用する

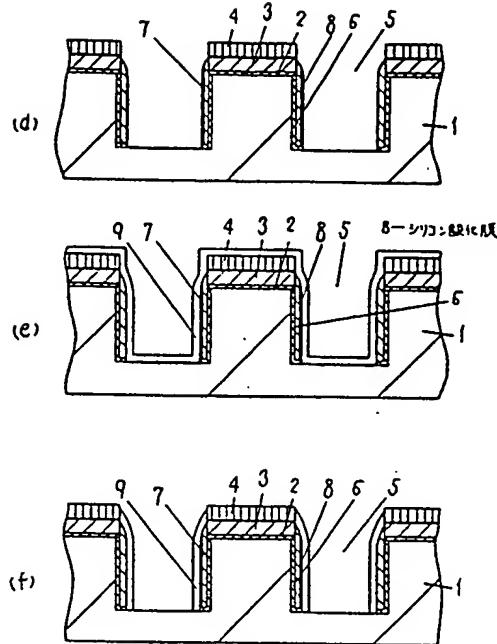
BEST AVAILABLE COPY

特開昭64-22051(4)

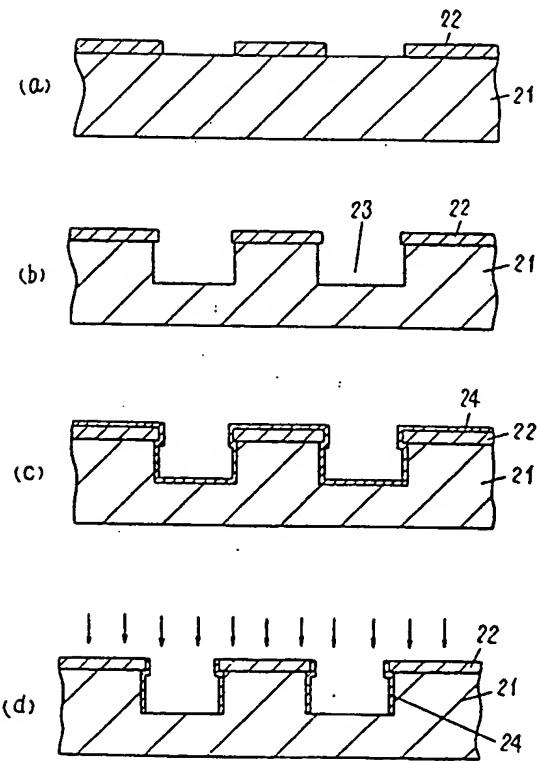
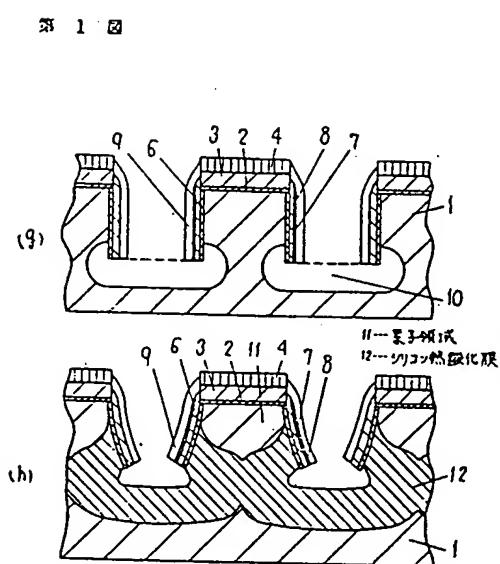
第1図



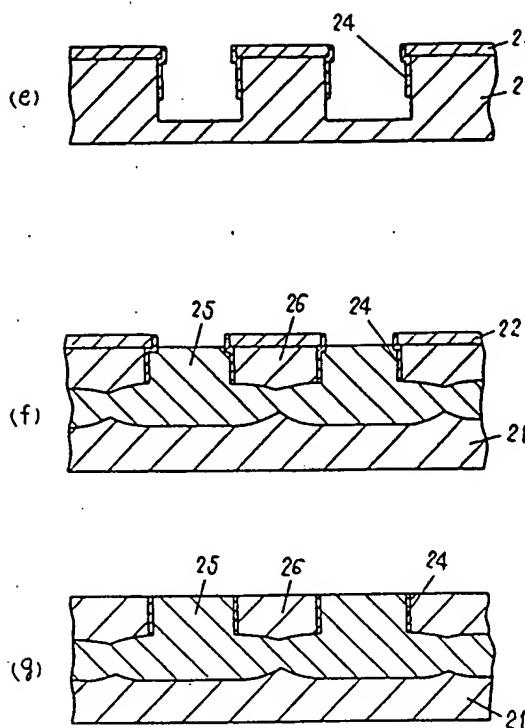
第1図



第2図



第2図



第2図

